

800G Tx TGV 光电 Interposer 芯片

产品介绍

800G Tx TGV 光电 Interposer 芯片通过激光诱导、深硅刻蚀实现基于玻璃基的信号转接，利用重布线层（RDL）和微凸点工艺，实现 110GHz 以上布线带宽，显著提升了信号传输效率和密度；匹配主流八通道硅光调制芯片和电驱动芯片，实现 8 通道标准化方案，同时兼容主流硅光芯片与电芯片的管脚定义，实现光电混合封装的高度集成化；片上可集成激光直写光波导与 interposer 内开槽，实现低损耗高密度的光路扇入扇出。

性能特点

- 8 英寸晶圆级 TGV MPW 流片
- RDL 和微凸点工艺、布线带宽超过 110GHz
- 支持光电芯片 Flipchip 封装
- 支持低损耗光波导激光直写
- 支持立体结构开槽，支持低损耗光耦合

关键参数指标

性能参数	范围
Interposer 芯片尺寸	10mm×9mm
interposer 玻璃厚度	265μm
布线带宽	> 110GHz
TGV 孔开口	60μm—25μm
RDL 线宽线距	80μm/15μm

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1202 室

座机：+86-755-84652252

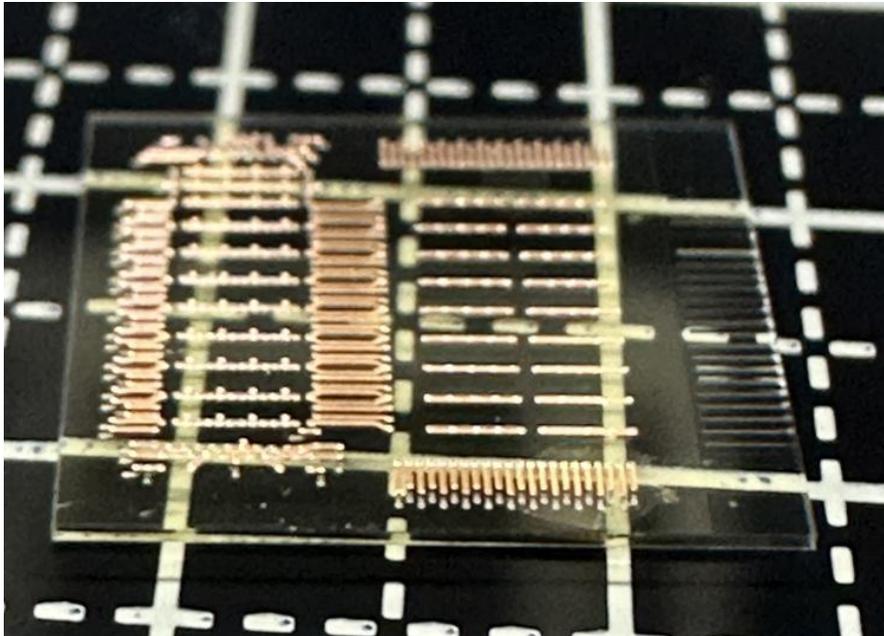
联系电话：+86-189 4877 6698

邮件：info@photonicsv.com

网址：<https://www.photonicsv.com>

RDL 厚度	3 μ m
PI 厚度	5 μ m
Bump 球径	60 μ m
T/Rx 通道	100G \times 8

TGV 芯片应用示意



地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1202 室

座机：+86-755-84652252

联系电话：+86-189 4877 6698

邮件：info@photonicsv.com

网址：<https://www.photonicsv.com>